

本願의 發明은 引用例와 技術的 課題를 전혀 달리하므로 引用例에 의해 容易하게 發明할 수 있다고는 할 수 없다고 判示한 事例

(東京高裁 59. 11. 28判決; 昭和 56年(行ヶ) 227號)

1. 事件概要

原告가 特許出願을 한 發明은 半導體裝置등의 製造方法에 관한 것으로서 半導體에 被着한 感光 laequer層을 光學 Mask를 의지해서 露光 한 상태가 되게한 감촉, 光學 Mask로서 周期律表의 IV~VIII族 元素中の 遷利元素에서 選擇한 적어도 1個의 金屬의 蒸着被膜을 가진 透明基材로서 되어 光學腐食한 patrn을 가진것을 使用하는 것을 主要 特徵으로 한다.

原告는 그 出願을 拒絶한 審決의 取消을 求하고 本願의 發明에 있어서 光學 Mask는 審決의 (引用例 3)에 記載하는 것으로는 그 目的, 効果가 전혀 다르다는 등의 主張을 했다.

2. 判決의 要旨

判決은 下記의 理由에 따라 原告의 請求를 認定하고 審決을 取消했다.

즉, 本願의 發明에 있어서 光學 Mask로서 金屬被膜을 利用하는 意味는 半導體裝置등에 있어서 微細한 pattern의 形成에서 問題가 되는 Fringe(映像의 輪郭을 不鮮明하게 하는 半陰影)의 影響을 除去하는 것에 있음에 對해서, (引用例 3)에서는 製版用 網陽板에 있어서 Mask의

嚴密修正을 하는 경우에는 網點自體의 濃度を 減少시키는 것이 없고 그 面積만을 작게하므로서 嚴密修正이 되는 것으로 하는 것에 있으므로 兩者의 技術的 課題는 전혀 다르므로 營業者가 後者에 있어서 金屬被膜을 利用하는 光學 Mask를, 前者에 경우 半導體裝置등에 있어서 極度の 明確함이 要求되는 微細한 構造의 pattern製作을 위해 利用하는 것에 想致하는 것은 반드시 容易하다고 보는 것은 아니다.

따라서 (引用例 1) 및 (引用例 2)에 審決 決定의 技術的 記載가 있으므로서도 이것과 (引用例 3)의 技術에서 本願의 發明이 容易하게 發明되었다고 한 審決의 判斷은 잘못되었다고 하지 않으면 안된다.

3. 論評

本件에 있는 것 같이 本件 發明의 構成要件의 一部를 開示하는 先行技術이 存在하여도 兩者에 있어서 技術的 課題가 다른 경우에는 그 先行技術에서 本件 發明이 容易하게 想致되는 것으로 있다고 하는 特別事由가 存在하지 않는한 그 先行技術을 引用해서 本件 發明의 進歩性を 否定하는 것은 안된다. <㉞>